05;06;12 Перемагничивание аморфных пленок гадолиний—кобальт с радиальным градиентом магнитных свойств

© В.Е. Иванов, Г.С. Кандаурова

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 620083 Екатеринбург, Россия e-mail: vladimir.ivanov@usu.ru

(Поступило в Редакцию 30 июня 2003 г.)

По наблюдениям доменной структуры и измерениям магнитооптических петель гистерезиса изучены интегральные характеристики процесса перемагничивания аморфной пленки гадолиний-кобальт с перпендикулярной анизотропией, обладающей радиальным градиентом магнитных свойств, вызванных пространственно-неоднородным тепловым полем. Найден простой способ моделирования процесса перемагничивания областей пленки, где движение доменной границы определяется только коэрцитивной силой. Показано, что в первом приближении локальные процессы перемагничивания происходят независимо и результирующая петля гистерезиса может быть получена сложением локальных петель гистерезиса.

Доменная структура (ДС) в пленках с перпендикулярной анизотропией продолжает вызывать интерес исследователей благодаря возможности практического применения [1], с одной стороны, и обнаружению новых явлений [2,3], с другой стороны. Техническое использование пленок ферритов-гранатов стало возможным благодаря высокой чувствительности их ДС к магнитному полю, что делает эти пленки незаменимым материалом для визуализации магнитных полей [4]. Как показывает опыт, к температурным полям более чувствительна ДС металлических аморфных пленок [5], вследствие чего они могут использоваться для визуализации тепловых полей [6].

Процесс намагничивания тонких многодоменных пленок с перпендикулярной анизотропией хорошо изучен теоретически и экспериментально. Если коэрцитивность доменных границ H_C мала по сравнению с максимальным полем рассеяния $4\pi M_S$ или если приведенная коэрцитивность $h_C = H_C/4\pi M_S < 0.01$, где M_S намагниченность насыщения, то процесс намагничивания описывается теорией [7]. В магнетиках с большей коэрцитивностью необходимо учитывать гистерезисные эффекты. В этом случае восходящая и нисходящая ветви петли гистерезиса (ПГ) удовлетворительно описываются решением системы уравнений [8].

С ростом h_C процесс перемагничивания определяется все в большей степени коэрцитивной силой и ее дисперсией. Весь переход от "низкокоэрцитивного" состояния к "высококоэрцитивному" можно наблюдать в аморфных пленках Cd–Co при изменении температуры в интервале, включающем температуру магнитной компенсации. Действие пространственно неоднородного температурного поля будет в этом случае приводить к пространственной зависимости намагниченности M_S и коэрцитивной силы H_C , в результате чего кривая намагничивания становится координатно-зависимой характеристикой. В частности, возникает вопрос, является ли процесс намагничивания зависящим только от

локальных магнитных характеристик $M_S(x)$, $H_C(x)$ или будет иметь место корреляция между намагниченностью соседних областей. В данной работе была поставлена задача экспериментального изучения интегральных характеристик процесса перемагничивания неоднородной в плоскости по магнитным свойствам пленки Cd–Co, которая вызвана пространственной неоднородностью температуры (условно-точечным источником тепла) и определение возможности моделирования этого процесса.

Образцы и методика эксперимента

Аморфные пленки Cd–Co с перпендикулярной анизотропией толщиной $0.5-1\,\mu$ m получены методом ВЧ ионно-плазменного распыления на стеклянные водоохлаждаемые подложки и защищены со свободной поверхности стеклянным покрытием толщиной ~ 500 Å. Температура компенсации магнитного момента T_M была несколько выше комнатной и составляла $T_M \approx 53^{\circ}$ C.

Температурный градиент создавался благодаря разности температур между относительно массивным латунным "термостатом" и источником тепла, который представляет собой спай медь-константановой термопары. Нагревание "источника" осуществлялось пропусканием электрического тока по константановым проводникам, а термоэдс снималась с медь-константановой термопары. Поверхность теплового контакта "источника" и индикаторной аморфной пленки в первом приближении можно считать кругом с радиусом ~ 40 μ m. Температура исследуемых пленок (T) в этой области контакта считалась постоянной и приблизительно равной температуре "источника" (T_S).

Доменная структура наблюдалась при помощи полярного магнитооптического эффекта Керра через стеклянную подложку. Процесс намагничивания при фиксированной температуре источника T_S контролировался

измерением поверхностных магнитооптических ПГ в координатах j(H) в различных областях образца, где $j(H) = M/M_S$ — относительная намагниченность, M намагниченность в поле величиной Н. Это достигалось изменением поля зрения изучаемой доменной конфигурации при помощи полевой диафрагмы микроскопа. Полученные петли гистерезиса проходили оцифровку при помощи редактора Origin.

На рис. 1 представлены температурные зависимости намагниченности насыщения $M_{S}(T)$, коэрцитивной силы $H_C(T)$ и ширины доменов d_0 в размагниченном (равновесном) состоянии. Эти данные получены при измерениях в случае однородного теплового поля, т.е. без пространственного градиента температуры в плоскости пленки. Они необходимы для моделирования процессов намагничивания, а также для определения по параметрам ДС локальных температур и восстановления топограммы неоднородного температурного поля в плоскости пленки. Кривая на рис. 1, а построена по формуле

$$H_C = C/(T - T_M), \tag{1}$$

где C = 1500 — константа, которая определена из условия наилучшего совпадения с экспериментом.

Необходимая для расчета кривых намагничивания j(H) приведенная толщина L/l (здесь L — толщина пленки, $l = \sigma_w / 4\pi M_S^2$ — характеристическая длина материала, σ_w — плотность энергии доменных границ) была определена из уравнения Малека и Камберского [9] по известным значениям d_0/L .

Для анализа гистерезисных свойств была выбрана хорошо изученная конфигурация ДС [5], вызван-



Рис. 1. Температурные зависимости намагниченности насыщения (M_S) , коэрцитивной силы $H_C(a)$ и ширины доменов (b)аморфной пленки Gd-Co с температурой компенсации магнитного момента $T_M = 53^{\circ}$ С.



ная пространственно неоднородным центрально-симметричным температурным полем, создаваемым условноточечным источником тепла при температуре источника $T_{\rm S} = 195^{\circ}{\rm C}$ (рис. 2). В центре температура пленки значительно превышает Т_м, поэтому ДС здесь очень мелкая, едва различимая при наблюдениях: ширина доменов составляет ~ 4 µm. При удалении от центра и приближении Т к температуре компенсации ДС резко укрупняется. На рис. 2, *a*-*d* кругами различного диаметра показаны окна, с которых снимались ПГ. Ниже приведены радиальные зависимости температуры T(R), намагниченности насыщения $M_{S}(R)$ и относительной коэрцитивности доменных границ $h_C(R)$ (начало координат помещено в центр симметрии картины ДС), которые были построены по методике, предложенной в [6]. Соответствующие этим окнам ПГ показаны на рис. 3, a-d.

Петли, показанные на рис. 3, а и с, измерены при минимально возможном на опыте диаметре окна, причем центр окна (c) смещен относительно центра симметрии изучаемой доменной конфигурации. Видно, что при удалении от источника тепла наблюдается тенденция увеличения H_C , а поле зарождения H_P уменьшается, т.е. процесс возникновения обратной магнитной фазы затрудняется.

0.4

0.2 ^U

0



Рис. 3. *a*-*d* — экспериментальные магнитооптические петли гистерезиса, соответствующие "окнам" на рис. 2, *f* — рассчитанные петли гистерезиса.

С увеличением диаметра окна видна тенденция к росту коэрцитивной силы и сглаживанию петли гистерезиса (ср. рис. 3, a и b). Очевидно рост H_C связан с вкладом в процесс перемагничивания областей пленки с более высокой коэрцитивностью, температура которых приближается к T_M . Сглаживание петли в области поля зарождения обусловлено пространственной (радиальной) зависимостью этого поля.

Моделирование интегральной петли гистерезиса проводилось с учетом следующих соображений. Всю пленку можно разделить на две области. Одна из этих областей представляет собой круг с центром в начале координат и диаметром D_k (рис. 2). Она выбрана таким образом, чтобы в ней было справедливо соотношение $h_C = H_C/4\pi M_S \le 0.01$. Здесь рассчитывались локальные петли гистерезиса из уравнений [8]. Другая область кольцевая и заключена между окружностями с диаметром D_k и D_{max} с повышенной коэрцитивной силой $h_C > 0.01$. Для этой области предложен способ моделирования процесса перемагничивания в предположении отсутствия собственного размагничивающего поля. Интегральная ПГ получалась суммированием локальных ПГ с соответствующими весовыми множителями.

1. С целью расчета петель гистерезиса аналогично [6] была восстановлена координатная зависимость температуры с началом координат, помещенным в центр симметрии картины ДС (рис. 2). Экспериментальную кривую T(R) аппроксимировали линейной зависимостью $T = T_0 - \alpha R$, где $T_0 = 190^{\circ}$ С, $\alpha = 0.27^{\circ}$ С/ μ m. При этом считали, что температура в области касания пленки с источником тепла остается постоянной, поэтому непосредственно над источником можно выделить участок-плато (I на рис. 2), где магнитные свойства не меняются.

Петли гистерезиса j(H) для областей с небольшой коэрцитивной силой ($h_C > 0.01$) рассчитывались из уравнений [8]

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{4\pi^2 \alpha^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \sin^2 \left[\frac{\pi n(1+j)}{2} \right]$$
$$\times \left[1 - (1 + 2\pi n\alpha) \exp(-2\pi n\alpha) \right] \pm \frac{\pi h_C}{4\alpha}, \qquad (2)$$
$$h = j + \frac{1}{\pi^2 \alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \left[\pi n(1+j) \right]$$

$$\times \left[1 - \exp(-2\pi n\alpha)\right] \pm h_C,\tag{3}$$

где $\tau = (4M_S)^2 L/\sigma_w$, $\alpha = L/P = L/(d_1 + d_2)$, $h = H/4 \times \pi M_S$, $j = (d_1 - d_2)/(d_1 + d_2)$ — относительная намагниченность, σ_w — поверхностная плотность энергии доменных границ, d_1 и d_2 — ширина доменов с параллельным и антипараллельным внешнему полю вектором намагниченности, знаки "плюс" и "минус" соответствуют возрастанию и убыванию внешнего поля.

На рис. 4, *а* показана петля гистерезиса, рассчитанная по теории [8] с параметрами, соответствующими области плато (участок *I* кривой T(R) на рис. 2): $T = 180^{\circ}$ С, $d_0 = 2 \mu$ m, $M_S = 139$ Gs, $h_C = 0.006$. Далее рассчитана петля для $T = 150^{\circ}$ С (рис. 4, *b*) с параметрами $d_0 = 3 \mu$ m, $M_S = 103$ Gs, $h_C = 0.01$, что геометрически соответствует на пленке окружности с радиусом $R = 190 \mu$ m (точка 2 кривой T(R) на рис. 2).

2. При удалении от центра картины (рис. 2), что соответствует приближению к температуре компенсации, M_S уменьшается, H_C увеличивается и для данной пленки при $h_C > 0.013$ расчет по теории [8] становится некорректным. Поэтому моделирование процесса





Рис. 4. Рассчитанные по теории [8] петли гистерезиса для пленки Gd-Co при T = 180 (*a*) и 150° C (*b*).

перемагничивания для окна (c) на рис. 2 (на кривой T(R) на рис. 2 соответствующий участок отмечен также буковой c) проводилось исходя из следующих соображений. Считаем, что в кольцевой области пленки от $R_1 = 250 \,\mu\text{m}$ до $R_2 = 550 \,\mu\text{m}$ процесс намагничивания определяется в основном коэрцитивной силой пленки. Это оправдано тем, что в этой области намагниченность насыщения мала, следовательно, малы и размагничивающие поля рассеяния, которые могли бы формировать доменную структуру и в отсутствие магнитного поля. Для простоты полагаем, что в процессе перемагничивания существуют два домена: "белый" и "черный", причем положение междоменной границы подчиняется условию $H = H_C$.

На рис. 5 схематически показано прямоугольное окно, для которого проведены расчеты. Поместим начало координат (x = 0) в центр окна, тогда относительная намагниченность определяется следующим образом: j = x/a, где 2a — ширина окна вдоль радиуса R. В свою очередь координата определяется из условия $H = H_C(x)$. Зависимость x(H) можно найти с использованием (1) из уравнения

 $H_C(x) = C/(T(x) - T_M) = H(x),$

тогда

$$j = 1/\alpha a \left[[T_1 + T_2]/2 - T_k - C/H \right],$$
(4)

где α — пространственный градиент намагниченности, T_1 и T_2 — температуры на левой и правой границах области соответственно.

На рис. 3, e показана петля гистерезиса, нисходящая и восходящая ветви которой рассчитаны по формуле (4). Эта петля гистерезиса фактически является интегральной теоретической петлей гистерезиса для области пленки, соответствующего окну (c) на рис. 2, где перемагничивание происходит таким образом, что внешнему полю противодействует только коэрцитивная сила. Из сравнения этой петли (рис. 3, e) с экспериментальной петлей гистерезиса (рис. 3, c) видно, что проведенные расчеты по крайней мере качественно верно описывают реальный процесс перемагничивания.

3. Интегральная теоретическая петля гистерезиса, соответствующая окну (d) на рис. 2 с максимальным диаметром D_{max} была получена следующим образом. Относительная намагниченность результирующей петли jопределялась как сумма вкладов от рассчитанных выше намагниченностей с весовыми множителями, пропорциональными соответствующим площадям,

$$j(H) = \sum_{i=1}^{3} j_i(H)\rho_i,$$
 (5)

где i = 1, 2, 3 — номер кольцевой области, j_i — относительные намагниченности при данном значении поля H в *i*-м кольце; $\rho_i = S_i/S, S_i$ — площадь кругового кольца, соответствующего рассчитанной петле гистерезиса, S — площадь окна (c) максимального радиуса.

При этом предполагалось, что гистерезисные свойства этих кольцевых областей незначительно меняются по радиусу, так что рассчитанные теоретические петли гистерезиса описывают в среднем процесс намагничивания в каждом кольце. Конкретно в нашем случае отношения площадей $S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 1 : 6$. Сопоставление построенной таким образом теоретической интеграль-



Рис. 5. Упрощенная схема двухдоменной структуры участка пленки и соответствующая этому участку пленки координатная зависимость температуры и коэрцитивной силы. Стрелкой показано направление движения доменной границы.

ной петли гистерезиса (рис. 3, f) с экспериментальной магнитооптической петлей, которая соответствует максимально открытому окну (d) (рис. 3, d), указывает на качественное согласие теории и эксперимента. Различие заключается в наличии "ступенек" на теоретической петле, которые обусловлены грубостью моделирования, т. е. малым количеством шагов. Они могут быть сглажены сложением большего числа теоретических петель гистерезиса, рассчитанным с меньшим шагом по координате и соответственно по температуре и магнитным свойствам.

Заключение

Проведенные измерения и моделирование показали, что характеристики процесса перемагничивания аморфной пленки гадолиний—кобальт с доменной структурой, сформированной в пространственно неоднородном температурном поле, создаваемом условно-точечным источником тепла, существенно отличаются от случая однородного температурного поля. В случае однородного температурного поля петли гистерезиса, как правило, имеют ступенчатый характер перемагничивания в поле зарождения ДС. В пространственно неоднородном температурном поле возникающая координатная зависимость магнитных свойств пленки приводит к сглаживанию скачкообразных участков на петле гистерезиса.

Найден простой способ описания процесса намагничивания областей пленки с сильной пространственной зависимостью коэрцитивной силы для участков, где движение доменной границы определяется только коэрцитивной силой. Показано, что в первом приближении локальные процессы перемагничивания происходят независимо и результирующая петля гистерезиса может быть получена сложением локальных петель гистерезиса.

Авторы благодарят Л.В. Семенюк за помощь в работе.

Работа частично поддержана научными программами Минобразования "Университеты России", "Фундаментальные исследования в области естественных наук", фондом РФФИ-Урал и программой CRDF.

Список литературы

- [1] Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. Прикладная магнитооптика. М.: Энергоатомиздат, 1990. 318 с.
- [2] Кандаурова Г.С., Свидерский А.Э. // ЖЭТФ. 1990. Т. 97. С 1218–1230.
- [3] Кандаурова Г.С. // УФН. 2002. Т. 172. № 10. С. 1165–1187.
- [4] *Кубраов Н.Ф. //* Труды ИОФАН. М.: Наука, 1992. Т. 35. С. 136–164.
- [5] Иванов В.Е., Кандаурова Г.С. // ФММ. 1996. Т. 82. Вып. 3. С. 9674–105.
- [6] Иванов В.Е., Кандаурова Г.С., Свалов А.В. // ЖТФ. 1997. Т. 67. Вып. 7. С. 112–116.
- [7] Kooy C., Enz U. // Philips Res. Rep. 1960. Vol. 15. N 1. P. 7–29.

- [8] Masuda M., Yoshino S. // Res. Repts. Fac. Eng. Mie. Univ. 1980. Vol. 25. P. 59–68.
- [9] Malek Z., Kambersky V. // Cheh. J. Phys. 1958. Vol. 8. N 4. P. 416–421.